PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-338516

(43) Date of publication of application: 27.11.2002

(51)Int.CI.

CO7C 63/70 CO7C 67/307 CO7C 69/80 C07C231/12 CO7C233/66 CO7C237/22 C07C249/12 CO7C251/38 C07C303/30 C07C309/66 C07C313/04 C07C319/20 C07C323/42 C07C323/44 CO7D213/64 C07D213/75 CO7D239/60 // C07B 61/00

CO7C 51/363

(21)Application number: 2001-134049

(22)Date of filing:

01.05.2001

(71)Applicant: NIPPON NOHYAKU CO LTD

(72)Inventor: KODAMA HIROYOSHI

SHIYOUHEI TAKESHI **NISHIDA TATSUKI** HINO TOMOKAZU **TSUBATA KENJI**

(30)Priority

Priority number : 2000131032

Priority date: 28.04.2000

Priority country: JP

2001076073

16.03.2001

JP

(11)

(54) METHOD OF PRODUCTION FOR 2-HALOGENATED BENZOIC ACIDS

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of production for 2-

halogenated benzoic acids.

SOLUTION: 2-Halogenated benzoic acids of formula (I) are produced by reacting benzoic acids of formula (II) with a halogenating agent in the presence of a Pd catalyst. (A is -OH, -OM (M is an alkali metal), -N(R6) R7 (R6 and R7 are each H, a 1-6C alkyl group, a (substituted) phenyl group or the like), R is H, a 1-6C alkyl group, a 1-6C alkylcarbonyl group, a carboxy group, a 1-12C alkoxycarbonyl group, a (substituted) phenylcarbonyl group or the like, n is 0-4, X is Cl, Br, I, and (R)n optionally forms a 3-4C alkylene or a 3-4C alkenylene condensed ring by substituting adjacent C on the benzene ring).

(1)

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-338516

(P2002 - 338516A)

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl. ⁷	•	識別記号		FΙ			Ŧ	-マコード(参考)
C 0 7 C	51/363			C 0 7	C 51/363			4 C 0 5 5
	63/70				63/70			4H006
	67/307	•			67/307			4H039
	69/80				69/80		Α	
	231/12			•	231/12			
			審査請求	未請求	請求項の数5	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く

特願2001-134049(P2001-134049) (21)出願番号 (22)出願日 平成13年5月1日(2001.5.1) 特願2000-131032(P2000-131032) (31)優先権主張番号 (32)優先日 平成12年4月28日(2000.4.28) 日本 (JP) (33)優先権主張国 特願2001-76073(P2001-76073) (31)優先権主張番号 平成13年3月16日(2001.3.16) (32)優先日 (33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000232623

日本農薬株式会社

東京都中央区日本橋1丁目2番5号

(72)発明者 児玉 浩宜

大阪府堺市陶器北685-7

(74)代理人 100068618

弁理士 萼 経夫 (外2名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 2-ハロゲン化安息香酸類の製造方法

(57)【要約】

【課題】 2-ハロゲン化安息香酸類の製造方法の提供。

*Pd触媒の存在下の反応させることを特徴とする式(I) の2-ハロゲン化安息香酸類の製造方法。

【化1】

【解決手段】 式(II)の安息香酸類とハロゲン化剤とを*

(式中、Aは-OH、-OM(式中、Mはアルカリ金属)、-N(R^6) R^7 (式中、 R^6 、 R^7 はH、 C_1-C_6 アルキル、(置換) フェニル等)、RはH、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 アルキルカルボニル、カルボキシル、 C_1-C_1 アルコキシカルボニル、(置換) フェニルカルボニ

ル等、nは $0\sim4$ 、XはC1、Br、I。又、(R) nはペンゼン環上の隣接するC上に置換して C_3 - C_4 アルキレン、 C_3 - C_4 アルケニレンからなる縮合環を形成することもできる。)

3 (1)

(式中、Xは塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子を示 し、A、R及びnは前記に同じ。)で表される2-ハロ ゲン化安息香酸類の製造方法。

【請求項2】 Aが-OH又は-OM(式中、Mはアル 10 カリ金属原子を示す。)を示す請求項1記載の製造方 法。

【請求項3】 Aが-N(R⁶) R⁷ (式中、R⁶ 及び R⁷ は同一又は異なっても良く、水素原子、 C₁-C₆アル キル基、フェニル基、同一又は異なっても良く、ハロゲ ン原子、シアノ基、ニトロ基、 C1-C6アルキル基、 C1-C₆ アルコキシ基、ハロ C₁-C₆ アルキル基、ハロ C₁-C₆ ア ルコキシ基、 C₁-C₆アルキルスルフィニル基又は C₁-C₆ アルキルスルホニル基から選択される一以上の置換基を 有するフェニル基又は

【化6】

(式中、R¹、R²、R³ 及びR⁴ は同一又は異なって も良く、水素原子、 C1-C6アルキル基を示し、R5 は C 1-C6アルキル基を示し、mはO乃至1の整数を示し、k は1乃至2の整数を示す。)を示す。)を示す請求項1 記載の製造方法。

R⁶ 及び R⁷ が同一又は異なっても良 【請求項4】 く、水素原子又は

【化7】

(式中、R¹、R²、R³ 及びR¹ は同一又は異なって も良く、水素原子又はC1-C6アルキル基を示し、R5 は C1-C6アルキル基を示し、mは0乃至1の整数を示し、 kは1乃至2の整数を示す。)を示す請求項3記載の製 造方法。

【請求項5】 R⁶ 及びR⁷ が同一又は異なっても良 く、水素原子、フェニル基、又は同一若しくは異なって も良く、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、C1-C6ア 基、ハロ C₁-C₆アルコキシ基、 C₁-C₆アルキルスルフィ ニル基又は C₁-C₆アルキルスルホニル基から選択される 一以上の置換基を有するフェニル基である請求項3記載 の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は医薬及び農薬の製造 原料として有用な2-ハロゲン化安息香酸類の製造方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】2-ハロゲン化安息香酸類は、医薬及び 農薬の重要な製造原料であり、従来、2-アミノ安息香 酸類からのザンドマイヤー反応による製造方法(①. J. Am. Chem. Soc., 1923, 51, 19 71)、アルキルリチウム類を用いた安息香酸類のリチ 才化反応を利用する製造方法(②. J. Org. Che m., 1989, 54, 4372)、ヨウ素-発煙硫酸 を用いる製造方法(③. Org. Synth., III, 796, (1955)) 又はタリウム(III) トリフルオ 20 口酢酸を用いる製造方法 (④. J. Am. Chem. S oc., 2176(1970)) 等が知られている。 又、パラジウム触媒を用いてペンゼン環にハロゲンを導 入する方法も知られているが、基質が窒素原子等のヘテ ロ原子が直接ペンゼン環に置換した官能基が必要であっ たり(⑤. J. Chem. Soc. Commun., 1 970,417)、ペンジル位にヘテロ原子の置換した 官能基が必要であり(⑥. J. Organometa l. Chem., 262, C11 (1984))、その 大部分はパラジウムを化学量論量必要としている。パラ ジウムを触媒量使用している例においても触媒量として は、基質に対して5~20%程度のレベルにとどまって いる。安息香酸類を基質としてパラジウム触媒を用いて ベンゼン環に炭素置換基を導入する方法も知られている が (⑦. J. Org. Chem., 1998, 63, 5 211)、ハロゲン化の報告例は無く、触媒サイクルを 成立させるには銅塩及び酸素を組み合わせる必要があ る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、①の方法は爆 40 発の危険性を伴ったり、多量の酸性廃液を生じ、②の方 法では0℃以下の低温を必要とし、③の方法は多量の硫 酸廃液を生じ、位置選択性も不充分であり、④の方法は **毒性の強い金属を原料に対して当量以上必要とし、⑤及** び⑥の方法は安息香酸類には適用できないか、又は高価 なパラジウム触媒を多量に必要とし、⑦の方法は触媒的 ハロゲン化には適用できない。従来法ではコスト、危険 性、廃液等の問題から工業化に課題があったり、安息香 酸の特定の位置にハロゲン化を実現できないものであっ た。本発明は触媒量の金属を使用し、温和な条件下で進 ルキル基、ハロ C₁-C₆アルキル基、 C₁-C₆アルコキシ 50 行する位置選択的なハロゲン化反応の確立を課題とする

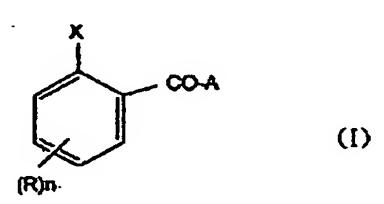
8

7

る一以上の置換基を有する置換へテロアリールオキシ基を示し、nは0~4の整数を示す。(R) nはペンゼン 環上の隣接する炭素原子上に置換して C₁-C₁アルキレン 基又は C₁-C₁アルケニレン基からなる縮合環を形成する こともできる。又、該アルキレン又はアルケニレン鎖上 に同一又は異なっても良く、1以上の置換基R (Rは前 記に同じ。)を有することもできる。)で表される安息 香酸類とハロゲン化剤とをパラジウム触媒の存在下に反 応することを特徴とする一般式(I):

[0011]

【化12】



(式中、Xは塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子を示し、A、R及びnは前記に同じ。)で表される2-ハロゲン化安息香酸類の製造方法に関するものである。

[0012]

【発明の実施形態】本発明の一般式(I) で表される2-ハロゲン化安息香酸類の定義において、「ハロゲン原 子」とは塩素原子、臭素原子、沃素原子又はフッ素原子 を示し、「 C₁-C₆アルキル」とは、例えばメチル、エチ*

*ル、n-プロピル、i-プロピル、n-ブチル、i-ブチル、s-ブチル、t-ブチル、n-ペンチル、n-ヘキシル等の直鎖又は分枝状の炭素原子数1~6個のアルキル基を示し、「ハロ C1-C6アルキル」とは、同一又は異なっても良い1以上のハロゲン原子により置換された直鎖又は分枝状の炭素原子数1~6個のアルキル基を示し、「C3-C4アルキレン」はプロピレン、トリメチレン、メチルプロピレン、テトラメチレン等の直鎖又は分枝状の炭素原子数3~4個のアルキレン基を示し、「C103-C4アルケニレン」とは、直鎖又は分枝状の分子中に二重結合を有する炭素原子数3~4個のアルケニレン基を示す。

【0013】「アルカリ金属原子」とは、例えばナトリウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属原子を示す。「ヘテロアリールオキシ基」とは、窒素原子を1~3個環上に有する6員複素環リールオキシ基を示し、例えば2-ピリジルオキシ基、3-ピリジルオキシ基、4-ピリジルオキシ基、3-ピリダジニルオキシ基、4-ピリダジニルオキシ基、2-ピリミジニルオキシ基、420-ピリミジニルオキシ基、5-ピリミジニルオキシ基、2-ピラジニルオキシ基、2-ピラジニルオキシ基、2-ドリアジニルオキシ基等を例示することができる。

【0014】本発明の2-ハロゲン化安息香酸類の製造方法を図式的に示すと、以下の通り示される。

【化13】

(式中、A、R、n及びXは前記に同じ。)

即ち一般式(I)で表される2-ハロゲン化安息香酸類はパラジウム触媒の存在下、一般式(II)で表される安息香酸類を適当な不活性溶媒の存在下又は不存在下に、種々のハロゲン化剤と反応させることにより製造することができる。パラジウム触媒としては、例えば酢酸パラジウム、塩化パラジウム、硝酸パラジウム等の2価のパラジ 40ウム及びそれらとの配位子として、例えばアセトニトリル、トリフェニルフォスフィン、ペンゾニトリル等の配位したパラジウム錯体を用いることができ、これらのパラジウム触媒は単独で使用しても二種以上を混合して使用しても良い。

【0015】パラジウム触媒の使用量は、一般式(II)で表される安息香酸類に対して触媒量で良く、通常1/10000当量~1/2当量程度を用いることができ、好ましくは1/10000当量~1/10当量程度を用いることができ、より好ましくは1/10000当量 50

~1/100当量程度を用いることができる。本反応で用いるハロゲン化剤としては、 I_2 、 Cl_2 、 Br_2 、ICl等の分子状ハロゲン、N-クロロコハク酸イミド、N-3ードコハク酸イミド、1, 3-ジョードヒダントイン、1, 3-ジョード-5, 5-ジメチルヒダントイン等の周期律表 15族の元素と結合したハロゲン原子を有する化合物を使用することができる。ハロゲン化剤の使用量は一般式(II)で表される安息香酸類に対して1/2当量から過剰量を使用することができるが、好ましくは 1 当量程度~3 当量程度、より好ましくは 1 当量程度である。

【0016】本反応で使用する不活性溶媒としては、本 反応の進行を著しく阻害しないものであれば良く、特に 制限はないが、酢酸等の有機酸系溶媒、ジオキサン、テ トラヒドロフラン(THF)、ジエチルエーテル等のエ ーテル系溶媒、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメ チルアセトアミド(DMA)、Nーメチルピロリドン等 11

. . .

•

物の粗生成物を得た。実施例1と同様に400MHz-NMRで分析した結果、目的の2-クロロー6-メチル安息香酸の生成率は83%であった。2位への塩素化の位置選択性は100%であった。

¹H-NMRケミカルシフト(δ値): 2.43(3H.s), 7.13(1H.m), 7.24(2H.m), 9.15(1H.s).

【0025】実施例8.実施例1と同様の反応器に酢酸 パラジウム17mg、1-3-ジヨード-5,5-ジメ チルヒダントイン154mg、2-(1,1-ジメチル -2-メチルチオエチルアミノカルポニル)-4'-へ プタフルオロイソプロピルー2'ーメチルペンズアニリ ド0. 4g及びTHF15mlを加え70℃で2. 5時 間、加熱攪拌した。反応終了後、反応液を冷却し、次い で水中に注ぎ込み、目的物を酢酸エチルで抽出した。分 液後、有機層をチオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和食塩水 で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。 溶媒を減圧下で留去することにより目的物の粗生成物を 得た。実施例1と同様に400MHz-NMRで分析し た結果、目的の2-(1,1-ジメチル-2-メチルチ オエチルアミノカルボニル) -3-ヨード-4'-ヘプ 20 タフルオロイソプロピル-2'-メチルペンズアニリド の生成率は88%であった。ヨウ素化の3位への位置選 択性は100%であった。

¹H-NMRケミカルシフト (δ値): 1.42(6H.s), 1.90(3H.s), 2.39(3H.s), 2.82(2H.s), 6.10(1H.s), 7.21(1H.t), 7.40(1H.s), 7.45(1H.d), 7.77(1H.d), 7.98(1H.d), 8.43(1H.d), 8.56(1H.s).

【0026】実施例9.実施例1と同様の反応器に酢酸パラジウム10mgとNークロロコハク酸イミド0.27g、2-(4-フルオロフェニルカルボニル)安息香 30酸0.5g及びびDMF20mlを加え70℃で3時間、加熱撹拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、次いで水中に注ぎ込み、酢酸エチルで抽出した。有機層をチオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下で留去することにより目的物の租生成物を得た。実施例1と同様に400MHz-NMRで分析した結果、目的の2-クロロー6-(4-フルオロフェニルカルボニル)安息香酸の生成率は80%であった。

¹H-NMRケミカルシフト (δ値): 7.09(1H.t), 7.38(1H.d), 7.50(1H.t), 7.59(1H.m), 7.75(1H.m), 8.09(1H.d), 10.72(1H.s).

塩素化の2位への位置選択性は100%であった。

【0027】実施例10. 実施例1と同様の反応器に酢酸パラジウム23mg、N-ヨードコハク酸イミド0. 23g、2-(3-(1, 1-ジメチル-2-メチルチオエチルアミノカルボニル)-4'-ヘプタフルオロイソプロピル-2'-メチル)ナフトアニリド0. 57g及びDMF20mlを加え70℃で2時間、加熱撹拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、次いで水中50

に注ぎ込み、酢酸エチルで目的物を抽出した。有機層を チオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄した 後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下で 留去し租生成物を得た。得られた租生成物をシリカゲル カラムクロマトグラフィー(酢酸エチル/n-ヘキサン =1/8)で精製し、1-ヨード-2-(1, 1-ジメ チルー2-メチルチオエチルアミノカルボニル)-4' ーヘプタフルオロイソプロピルー2'ーメチルー3ーナ フトアニリド0.57g(収率70%、融点228~2 30℃)を得た。1位へのヨウ素化の位置選択性は10 0%であった。

【0028】実施例11. 実施例1と同様の反応器に酢 酸パラジウム14mg、N-ヨードコハク酸イミド0. 23g, 2-(1, 1-3)ルアミノカルポニル) -4-クロロ-4' -ヘプタフル オロイソプロピルー2'ーメチルベンズアニリド0.3 4g及びDMF10mlを加え70℃で2時間、加熱撹 拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、次いで 水中に注ぎ込み、目的物を酢酸エチルで抽出した。有機 層をチオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄 した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧 下で留去することにより粗生成物を得た。得られた粗生 成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチ ル/n-ヘキサン=1/8)で精製し、2-(1, 1-ジメチルー2ーメチルチオエチルアミノカルボニル)ー 3-ヨードー4-クロロー4'-ヘプタフルオロイソプ ロピルー2'ーメチルペンズアニリド0.32g(収率 78%、融点225℃)を得た。3位へのヨウ素化の位 置選択性は100%であった。

【0029】実施例12. 実施例1と同様の反応器に酢 酸パラジウム2mg、1,3-ジョード-5,5-ジメ チルヒダントイン1.72g、2-(1,1-ジメチル -2-メチルスルフィニルエチルアミノカルポニル)-4'-ヘプタフルオロイソプロピル-2'-メチルベン ズアニリド4. 8g及びTHF90mlを加えて70℃ で5時間、加熱撹拌した。反応終了後、反応液を室温ま で冷却し、次いで水中に注ぎ込み、目的物を酢酸エチル で抽出した。有機層をチオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和 食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥 40 した。溶媒を減圧下で留去することにより粗生成物を得 た。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラ フィー(酢酸エチル/n-ヘキサン=1/3)で精製 し、3-ヨードー2-(1,1-ジメチル・2-メチル スルフィニルエチルアミノカルボニル) - 4' - ヘプタ フルオロイソプロピルー2'ーメチルベンズアニリド 5. 5 g (収率 9 2 %) を得た。 3 位へのヨウ素化の位 置選択性は100%であった。

'H-NMRケミカルシフト (δ値): 1.60(6H.d), 2.21(3H.s), 2.38(3H.s), 2.85(1H.d), 3.10(1H.d), 6.68(1H.s), 7.22(1H.t), 7.42(1H.s), 7.48(1H.d), 7.78(1H.d), 8.

方法で、2-(1, 1-ジメチル-2-メチルチオエチルアミノカルボニル)-4-フルオロー4'-ヘプタフルオロイソプロピルー2'-メチルベンズアニリドから <math>2-(1, 1-ジメチル-2-メチルチオエチルアミノカルボニル)-4-フルオロー4'-ヘプタフルオロイソプロピルー3-ヨードー2'-メチルベンズアニリド(収率<math>7.9%、融点2.1.8~2.2.0%)を得た。3位へのヨウ素化の位置選択性は1.0.0%であった。

実施例 2 3. 実施例 2 2 と同様の方法で、5-2000-2-(1, 1-ジメチル-2-メチルチオエチルアミノカルボニル) - 4'-ヘプタフルオロイソプロピルー2'-メチルベンズアニリドから<math>5-200-2-(1, 1-ジメチル-2-メチルチオエチルアミノカルボニル) - 4'-ヘプタフルオロイソプロピル-3-ヨード-2'-メチルベンズアニリド(収率<math>80%、融点2 2 7 $\mathbb C$) を得た。 3 位へのヨウ素化の位置選択性は100%であった。

【0038】実施例26. 実施例22と同様の方法で、2-(1, 1-ジメチル-2-メチルチオエチルアミノカルポニル)-4'-ヘプタフルオロイソプロピルー4-メトキシー2'-メチルペンズアニリドから2-(1, 1-ジメチル-2-メチルチオエチルアミノカルポニル)-4'-ヘプタフルオロイソプロピルー3-ヨード-4-メトキシー2'-メチルペンズアニリド(収率84%、融点153~155℃)を得た。3位へのヨウ素化の位置選択性は100%であった。

ードー2'ーメチルー4ートリフルオロメトキシベンズアニリド(収率86%、融点213~214 $^{\circ}$)を得た。3位へのヨウ素化の位置選択性は100%であった。

16

【0039】実施例28. 実施例22と同様の方法で、3-(1,1-i)メチルー2-iメチルーカルボニル)-4 -10 -

実施例29. 実施例22と同様の方法で、2'ーメチルー8ー(1ーメチルー2ーメチルチオエチルアミノカルボニル)ー4'ートリフルオロメトキシー1ーナフタレンカルボン酸アニリドから7ーヨードー2'ーメチルー8ー(1ーメチルー2ーメチルチオエチルアミノカルボニル)ー4'ートリフルオロメトキシー1ーナフタレンカルボン酸アニリド(収率75%、融点176~178℃)を得た。1位へのヨウ素化の位置選択性は100%であった。

【0040】実施例30. 実施例22と同様の方法で、2-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)-N-(1, 1-ジメチル-2-メチルチオエチル)ベンズアミドから2-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)-N-(1, 1-ジメチル-2-メチルチオエチル)-6-ヨードベンズアミド(収率85%、融点128~130℃)を得た。6位へのヨウ素化の位置選択性は100%であった。

実施例 31. 実施例 22 と同様の方法で、2-(3-2) ロロー 5- トリフルオロメチルピリジンー 2- イルオキシ) - N - (1, 1- ジメチルー 2- メチルチオエチル) ベンズアミドから 2- (3- クロロー 5- トリフルオロメチルピリジンー 2- イルオキシ) - N - (1, 1- ジメチルー 2- メチルチオエチル) - 6- ヨードベンズアミド (収率 81%、融点 83~ 85 $\mathbb C$) を得た。 6位への 30 党化の位置選択性は 100% であった。

【0041】実施例32.実施例22と同様の方法で、40 2-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルオキシ)-N-(1,1-ジメチル-2-メチルチオエチル)ペンズアミドから2-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルオキシ)-N-(1,1-ジメチル-2-メチルチオエチル)-6-ヨードベンズアミド(収率89%、屈折率1.5765(21.0℃))を得た。6位へのヨウ素化の位置選択性は100%であった。実施例33.実施例22と同様の方法で、N-(1,1-ジメチル-2-メチルチオエチル)-2-(4-トリフルオロメチルフェニル)ベンズアミドからN-(1,50-1)

20

0mg、モレキュラーシブス4A0. 4g及びDMF5mlそしてスチレンに代えてヨウ素0. 75gを加え100℃で8時間、加熱攪拌した。反応終了後、反応液を冷却し、次いで水中に注ぎ込み、目的物を酢酸エチルで抽出した。分液後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧下で留去することにより目的物の粗生成物を得た。実施例1と同様に400MHz-NMRで分析した結果、目的の2-ヨード安息香酸の生成率は10%であった。

¹H-NMRケミカルシフト (δ値): 7.35(1H.t), 7.49(1H.t), 7.72(1H.d), 7.99(1H.d), 10.32(1H.s).

【0047】比較例2. 実施例13と同様のモル比で文献⑦に記載の反応条件に従い、反応を実施した。酢酸パラジウム5mgとo-トルイル酸0.3g、酢酸銅4.

4mg、N-ヨードコハク酸イミド0.5g及びモレキュラーシブス4A0.4g、DMF11mlを加え100℃で6時間、加熱攪拌した。反応終了後、反応液を冷却し、次いで水中に注ぎ込み、酢酸エチルで目的物を抽出した。分液後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧下で留去することにより租生成物を得た。実施例1と同様に400MHz-NMRで分析した結果、目的の2-ヨード安息香酸の生成は認められず、10%の構造不明物と90%の原料回収であった。比較例1及び2に示した通り、文献⑦記載の方法ではヨ

10 比較例1及び2に示した通り、文献⑦記載の方法ではヨウ素化 (ハロゲン化) は全く進行しないか又は極めて低収率であり、本発明がハロゲン化の方法として明らかに優れている。

1

フロントページの続き	
(E1) I (O) 7	

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 0 7 C 233/	/ 66	C 0 7 C 233/66	
237,	/22	237/22	-
249,	/12	249/12	
251,	/38	251/38	
303/	/30	303/30	
309/	/ 66	309/66	
313/	' 04	313/04	
319/	/20	319/20	
323/	/ 42	323/42	
323/	/ 44	323/44	
C 0 7 D 213/	'64	C 0 7 D 213/64	
213/	/75	213/75	
239/	′ 60	239/60	
// C 0 7 B 61/	00 3 0 0	C 0 7 B 61/00	3 0 0

(72)発明者 勝平 健Fターム(参考)大阪府河内長野市向野町765-4-301

(72)発明者 西田 立樹

大阪府富田林市甲田3丁目7-22-202

(72)発明者 日野 智和

大阪府富田林市廿山2丁目11-37-507

(72)発明者 津幡 健治

大阪府河内長野市大矢船北町8-9

Fターム(参考) 4C055 AA01 BA02 BA03 BA05 BA06

BA42 BA53 BB01 BB02 BB11

BB14 CA02 CA39 CA53 CB04

CB11 CB14 DA01

4H006 AA02 AC30 BA25 BE53 BJ20

BM72 BM73 BM74 BS30 BV22

BV70 BV72 BW12 BW31 KA31

KC30 TA02 TA04

4H039 CA52 CA53 CA54 CD10